

**КЛАСТЕРНАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ:
КЛАСТЕРЫ-ПРЕКУРСОРЫ $K3$, $K4$, $K5$, $K7$, $K8$ ДЛЯ САМОСБОРКИ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР $\text{Lu}_{66}\text{Te}_{24}\text{-}mC90$,
 $\text{Te}_4\text{Lu}_{28}\text{-}oC32$, $\text{Lu}_3(\text{TeLu}_3)\text{Lu}_2\text{-}hP9$ И $\text{Lu}_4\text{Te}_4\text{-}cF8$**

© 2023 г. В. Я. Шевченко^{1, *}, Г. Д. Илюшин^{2, **}

¹Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН,
наб. Макарова, 2, Санкт-Петербург, 199034 Россия

²Научно-исследовательский центр “Кристаллография и фотоника”,
Ленинский пр., 59, Москва, 119333 Россия

*e-mail: shevchenko@isc.nw.ru

**e-mail: gdilyushin@gmail.com

Поступила в редакцию 19.12.2022 г.

После доработки 01.02.2023 г.

Принята к публикации 08.02.2023 г.

С помощью компьютерных методов (пакет программ ToposPro) осуществлен комбинационно-топологический анализ и моделирование самосборки кристаллических структур $\text{Lu}_4\text{Te}_4\text{-}oF8$ ($Fm\text{-}3m$, $V = 211.0 \text{ \AA}^3$), $\text{Te}_4\text{Lu}_{28}\text{-}oC32$ ($Cmcm$, $V = 908.3 \text{ \AA}^3$), $\text{Lu}_3(\text{TeLu}_3)\text{Lu}_2\text{-}hP9$ ($P\text{-}62m$, $V = 908.3 \text{ \AA}^3$), $\text{Lu}_{66}\text{Te}_{24}\text{-}mC90$ ($C12/m1$, $V = 2467.2 \text{ \AA}^3$). Для кристаллической структуры $\text{Lu}_4\text{Te}_4\text{-}oF8$ установлены кластеры-прекурсоры $K8 = 0@Te_4Lu_4$ с симметрией $\text{-}43m$, для $\text{Te}_4\text{Lu}_{28}\text{-}oC32$ – тетраэдрические кластеры-прекурсоры $K4 = 0@Lu_4$ и $K4 = 0@TeLu_3$ с симметрией 2 и m , для $\text{Lu}_3(\text{TeLu}_3)\text{Lu}_2$ – кластеры-прекурсоры $K7 = 0@Lu_3(\text{TeLu}_3)$ с симметрией $3m$ и спейсеры Lu. Для кристаллической структуры $\text{Lu}_{66}\text{Te}_{24}\text{-}mC90$ установлены кластеры-прекурсоры в виде пирамиды $K5 = 0@Lu_5$ с симметрией 2, тетраэдры $K4 = 0@Lu_4$ с симметрией 2, тетраэдры $K4 = 0@TeLu_3$ и тетраэдры $K4 = 0@TeLu_2$, и кольца $K3 = 0@TeLu_2$, участвуют в образовании супракластеров-тримеров. Реконструирован симметричный и топологический код процессов самосборки 3D структур из кластеров-прекурсоров в виде: первичная цепь → → слой → каркас.

Ключевые слова: интерметаллиды $\text{Lu}_4\text{Te}_4\text{-}oF8$, $\text{Te}_4\text{Lu}_{28}\text{-}oC32$, $\text{Lu}_3(\text{TeLu}_3)\text{Lu}_2\text{-}hP9$ и $\text{Lu}_{66}\text{Te}_{24}\text{-}mC90$, самосборка кристаллической структуры, кластеры-прекурсоры $K3$, $K4$, $K5$, $K7$, $K8$

DOI: 10.31857/S0132665122600947, **EDN:** SLCWBB

ВВЕДЕНИЕ

В двойных системах $A\text{-}T$ ($T = \text{Se}, \text{Te}$) установлено образование 623 селенидов и 614 теллуридов A_xT_y с атомами $A = \text{Sc}, \text{Y}, \text{Zr}, \text{U}, \text{Ti}, \text{V}, \text{Cr}, \text{Fe}, \text{Co}, \text{Ni}, \text{Cu}$, лантанидами $Ln = \text{La}\text{-}\text{Lu}$ [1, 2]. Наиболее многочисленным является кристаллохимическое семейство $A_2T_2\text{-}cF8$ с пр. группой $Fm\text{-}3m$, насчитывающее 36 селенидов и 37 теллуридов.

В системе $\text{Lu}\text{-}\text{Te}$ (табл.1) интерметаллиды $\text{LuTe}_3\text{-}oC16$ [3], $\text{LuTe}_2\text{-}tP6$ [3], $\text{Lu}_2\text{Te}_3\text{-}oF80$ [4] и $\text{Lu}_4\text{Te}_4\text{-}cF8$ [5] имеют кристаллохимических аналогов среди интерметаллидов Sc_xTe_y (табл. 2, [9–14]) и интерметаллидов Y_xTe_y (табл. 3, [15–17]) и среди других интерметаллидов с большими атомами A .

Таблица 1. Система Lu–Te. Кристаллографические данные

Соединение	Группа симметрии	Параметры элементарной ячейки в Å, угол в градусах	$V, \text{Å}^3$
LuTe ₃ -oC16 [3]	<i>Cmcm</i>	4.277, 25.137, 4.278	459.9
LuTe ₂ -tP6 [3]	<i>P4/nmm</i>	4.222, 4.222, 8.807	157.0
Lu ₂ Te ₃ -oF80 [4]	<i>Fddd</i>	12.022, 8.499, 25.497	2605.2
Lu ₄ Te ₄ -cF8 [5]	<i>Fm-3m</i>	5.953, 5.953, 5.953	211.0
Lu ₈ Te- <i>hP9</i> [6]	<i>P-62m</i>	9.000, 9.000, 3.687	258.6
Te ₄ Lu ₂₈ -oC32 [6]	<i>Cmcm</i>	3.742, 12.278, 19.770	908.3
Lu ₆₆ Te ₂₄ -mC90 [7]	<i>C12/m1</i>	30.412, 3.950, 21.073, 102.96	2467.2
Lu- <i>cI2</i> [8]	<i>Im-3m</i>	3.900, 3.900, 3.900	59.32

Таблица 2. Система Sc–Te. Кристаллографические данные

Соединение	Группа симметрии	Параметры элементарной ячейки в Å, угол в градусах	$V, \text{Å}^3$
Sc ₂ Te ₃ -oF80 [10]	<i>Fddd</i>	8.222, 11.629, 24.608	2353.0
Sc ₄ Te ₄ -cF8 [1]	<i>Fm-3m</i>	5.817, 5.817, 5.817	196.8
ScTe- <i>hP4</i> [1]	<i>P6₃/mmc</i>	4.130, 4.130, 6.749	99.7
ScTe- <i>hP8</i> [11]	<i>P6₃/mmc</i>	4.097, 4.097, 13.602	197.7
Sc ₂ Te- <i>oP36</i> [12]	<i>Pnma</i>	20.178, 3.919, 10.675	844.1
Sc ₈ Te ₃ -mC88 [13]	<i>C12/m1</i>	28.842, 3.852, 22.352, 122.51	2094.0
Sc ₉ Te ₂ -oC88 [14]	<i>Cmc2₁</i>	7.758, 15.654, 17.283	2098.8

Три кристаллические структуры Te₄Lu₂₈-oC32 (TeLu₇, *Cmcm*, $V = 908.3 \text{ Å}^3$) [6], Lu₃(TeLu₃)Lu₂-*hP9* (TeLu₈, *P-62m*, $V = 908.3 \text{ Å}^3$) [6], Lu₆₆Te₂₄-mC90 (Lu₁₁Te₄, *C12/m1*, $V = 2467.2 \text{ Å}^3$) [7] не имеют кристаллохимических аналогов.

Кристаллические структуры TeLu₇-oC32 и TeLu₈-*hP9* рассмотрены в [6] как новые варианты замещения атомов в металлическом лютетии Lu [8].

Кристаллическая структура Lu₆₆Te₂₄-mC90 в [7] интерпретирована как слоистая и проведено ее сравнение со слоистыми структурами Sc₈Te₃-mC88 [13] и Ti₁₁Se₄-mS90 [18].

В настоящей работе проведен геометрический и топологический анализ кристаллических структур Lu₂Te₂-cF8, TeLu₇-oC32, TeLu₈-*hP9*, Lu₆₆Te₂₄-mC90. Установлены кластеры-прекурсоры *K3*, *K4*, *K5*, *K7*, *K8* участвующие в сборке кристаллических

Таблица 3. Система Y–Te. Кристаллографические данные

Соединение	Группа симметрии	Параметры элементарной ячейки в Å	$V, \text{Å}^3$
YTe ₃ -oC16 [15]	<i>Cmcm</i>	4.303, 25.490, 4.303	472.0
YTe ₂ -tP6 [3]	<i>P4/nmm</i>	4.291, 4.291, 8.912	164.1
Y ₂ Te ₃ -oF80 [4]	<i>Fddd</i>	12.228, 8.645, 25.935	2741.6
YTe-cF8 [16]	<i>Fm-3m</i>	6.095, 6.095, 6.095	226.4
Y ₇ Te ₂ -oP36 [17]	<i>Pnma</i>	21.328, 4.056, 11.401	986.3

Таблица 4. Lu₄Te₄-*cF8*. Координационные последовательности и локальное окружение атомов в кристаллической структуре

Атом	Локальное окружение	Координационные последовательности				
		N1	N2	N3	N4	N5
Te1	6 Lu	6	50	138	296	404
Lu1	6Te + 12Lu	18	74	170	306	482

Таблица 5. Te₄Lu₂₈-*oC32*. Координационные последовательности и локальное окружение атомов в кристаллической структуре

Атом	Локальное окружение	Координационные последовательности				
		N1	N2	N3	N4	N5
Te1	2Te + 9Lu	11	42	93	176	279
Lu1	1Te + 11Lu	12	45	105	183	291
Lu2	2Te + 11Lu	13	46	102	182	287
Lu3	12Lu	12	47	103	185	290
Lu4	3Te + Lu1	13	46	99	188	289

структур. Реконструирован симметричный и топологический код процессов самосборки 3D структур из кластеров-прекурсоров в виде: первичная цепь → слой → каркас.

Работа продолжает исследования [19–23] в области моделирования процессов самоорганизации систем на супраполиэдрическом уровне и геометрического и топологического анализа кристаллических структур с применением современных компьютерных методов.

МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ АНАЛИЗЕ

Геометрический и топологический анализ осуществляли с помощью комплекса программ ToposPro [24], позволяющего проводить многоцелевое исследование кристаллической структуры в автоматическом режиме, используя представление структур в виде фактор-графов.

Данные о функциональной роли атомов при образовании кристаллической структуры получены расчетом координационных последовательностей, т.е. наборов чисел $\{N_k\}$, где N_k – число атомов в k -ой координационной сфере данного атома. Полученные значения координационных последовательностей атомов для Lu₄Te₄-*cF8*, Te₄Lu₂₈-*oC32*, Lu₃(TeLu₃)Lu₂-*hP9*, Lu₆₆Te₂₄-*mC90*, приведены в табл. 4–7.

Алгоритм разложения в автоматическом режиме структуры любого интерметаллида, представленного в виде свернутого графа, на кластерные единицы основывается на следующих принципах: структура образуется в результате самосборки из нанокластеров-прекурсоров образующих каркас структуры, пустоты в котором заполняют спейсеры; кластеры-прекурсоры занимают высокосимметричные позиции; набор нанокластеров-прекурсоров и спейсеров включает в себя все атомы структуры.

СИММЕТРИЙНЫЙ И ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ КОД (ПРОГРАММА) САМОСБОРКИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Использованный нами метод моделирования кристаллической структуры основан на определении иерархической последовательности ее самосборки в кристаллографи-

Таблица 6. $\text{TeLu}_8\text{-}hP9$. Координационные последовательности и локальное окружение атомов в кристаллической структуре

Атом	Локальное окружение	Координационные последовательности				
		N1	N2	N3	N4	N5
Te1	2Te + 9Lu	11	41	110	191	305
Lu1	2Te + 12Lu	14	50	114	198	314
Lu2	1Te + 12Lu	13	49	112	201	311
Lu3	11Lu	11	47	104	197	311

Таблица 7. $\text{Lu}_{66}\text{Te}_{24}\text{-}mC90$. Координационные последовательности и локальное окружение атомов в кристаллической структуре

Атом	Локальное окружение	Координационные последовательности				
		N1	N2	N3	N4	N5
Te1	4Te + 8Lu	12	47	107	200	316
Te2	2Te + 9Lu	11	47	106	197	319
Te3	4Te + 7Lu	11	46	108	200	320
Te4	5Te + 7Lu7	12	45	114	200	331
Te5	3Te + 9Lu	12	46	109	210	336
Te6	4Te + 8Lu	12	44	106	201	317
Lu1	4Te + 10Lu	14	52	116	207	337
Lu2	3Te + 10Lu	13	51	111	207	338
Lu3	5Te + 12Lu	17	55	119	212	336
Lu4	3Te + 11Lu	14	51	117	209	339
Lu5	4Te + 11Lu	15	55	118	207	342
Lu6	2Te + 12Lu	14	57	123	227	348
Lu7	1Te + 13Lu	14	53	130	238	356
Lu8	4Te + 10Lu	14	50	121	216	340
Lu9	4Te + 10Lu	14	50	118	209	337
Lu10	4Te + 9Lu	13	54	122	219	347
Lu11	2Te + 12Lu	14	54	118	215	331
Lu12	3Te + 11Lu	14	53	118	214	339
Lu13	2Te + 12Lu	14	51	117	208	336
Lu14	1Te + 13Lu	14	50	119	217	343
Lu15	4Te + 11Lu	15	51	118	216	340
Lu16	2Te + 12Lu	14	52	114	208	335
Lu17	14Lu	14	52	112	204	328

ческом пространстве. На первом уровне самоорганизации системы определяется механизм формирования первичной цепи структуры из нанокластеров 0-уровня, сформированных на темплатной стадии химической эволюции системы, далее — механизм самосборки из цепи слоя (2-ой уровень) и затем из слоя — трехмерного каркаса структуры (3-й уровень).

Кристаллическая структура $\text{Lu}_4\text{Te}_4\text{-oF8}$

Пространственная группа $Fm-3m$ (no. 225) характеризуется набором элементов с точечной симметрией $g = m-3m, -43m, mmm$ и др. Индекс Пирсона соответствует $cF8$, т.е. в элементарной ячейке находится 8-ми атомный кластер $K8$. Атомы Lu и Te занимают позиции $4a (0, 0, 0)$ и $4b (1/2, 1/2, 1/2)$ с симметрией $m-3m$.

Кластер-прекурсор $K8 = 0@Te_4(Lu_4)$ представляет собой тетраэдр Lu_4 на гранях которого находятся атомы Te (рис. 1). Длины связей атомов Lu—Lu в тетраэдре 4.209 \AA и Lu—Te = $3 \times 2.977 \text{ \AA}$ (рис. 1). В локальном окружении атома Te находятся 6 атомов Lu, атома Lu — 12 атомов Lu и 6Te (табл. 5).

В элементарной ячейке $\text{Lu}_4\text{Te}_4\text{-oF8}$ находится один атомный кластер $K8$. Центр кластера расположен в позиции $8c (1/4, 1/4, 3/4)$ с симметрией $-43m$.

Первичная цепь S_3^1 . Первичная цепь S_3^1 формируется в результате связывания кластеро-прекурсоров $K8 + K8$ с индексом связности $P_c = 8$.

Самосборка слоя S_3^2 . Образование микрослоя $S_3^2 = S_3^1 + S_3^1$ происходит связыванием параллельно расположенных цепей. При связывании первичных цепей индекс связности $P_c = 8 + 8 + 2$ (рис. 1).

Самосборка каркаса S_3^3 . Микрокаркас структуры S_3^3 формируется при упаковке (без сдвига) микрослоев. Расстояние между микрослоями соответствует значению параметра кубической ячейки.

Кристаллическая структура $\text{Te}_4\text{Lu}_{28}\text{-oC32}$

В элементарной ячейке $\text{Te}_4\text{Lu}_{28}$ находятся 32 атома. В локальном окружении атома Te находятся 11 атомов (2Te + 9Lu), атома Lu1 находятся 12 атомов (1Te + 11Lu), атома Lu2 находятся 13 (2Te + 11Lu), атома Lu3 — 12 Lu, атома Lu4 — 3Te + 10Lu (табл. 5). Длины связей атомов в кристаллической структуре приведены на рис. 2, 3.

Рассматривается вариант самосборки кристаллической структуры из образующих упаковки 4-атомных тетраэдрических кластеро-прекурсоров $K4(2) = 0@Lu_4$ и $K4(m) = 0@TeLu_3$ с симметрией 2 и m (рис.2).

Первичная цепь S_3^1 . Самосборка первичных цепей из кластеро-прекурсоров $K4(2)$ и $K4(m)$ происходит в направлении кратчайшей оси a с индексом связанности кластеро-прекурсоров $P_c = 8$ (равному числу связей: 1 Te—Te + 7 Lu—Lu) и 8 Lu—Lu (рис. 3). Расстояние между центрами кластеро-прекурсоров $K4(2)$ и $K4(m)$ соответствует значению вектора трансляции $a = 3.742 \text{ \AA}$.

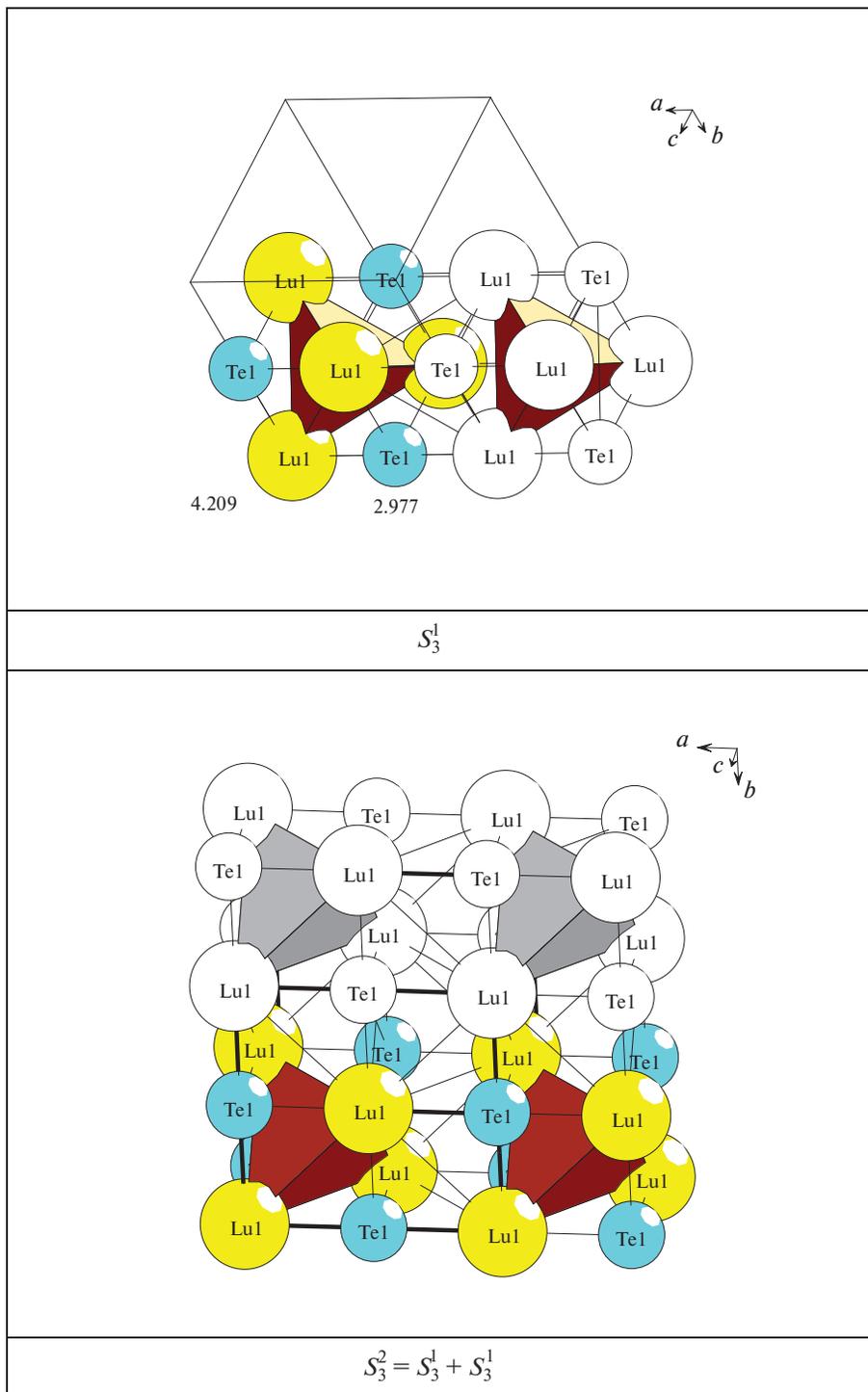
Самосборка слоя S_3^2 . Образование микрослоя S_3^2 происходит при связывании первичных цепей в плоскости элементами симметрии $g = -1$.

Самосборка каркаса S_3^3 . Микрокаркас структуры формируется при связывании двух микрослоев S_3^2 в направлении оси X (рис. 3).

Кристаллическая структура $\text{Lu}_3(\text{TeLu}_3)\text{Lu}_2\text{-hP9}$

В элементарной ячейке $\text{Lu}_3(\text{TeLu}_3)\text{Lu}_2$ находятся 9 атомы. В локальном окружении атома Te находятся 11 атомов (2Te + 9Lu), атома Lu1 находятся 15 атомов (2Te + 10Lu), атома Lu2 — 13 (1Te + 12Lu), атома Lu3 — 11Lu (табл. 6). Длины связей атомов в кристаллической структуре приведены на рис. 4.

Рассматривается вариант самосборки кристаллической структуры из образующих упаковки 7-атомных кластеро-прекурсоров $K7 = 0Lu_3(\text{TeLu}_3)$ с участием атомов-спейсеров Lu2 (рис. 4).

Рис. 1. Кристаллическая структура $\text{Te}_4\text{Lu}_4\text{-cF8}$.

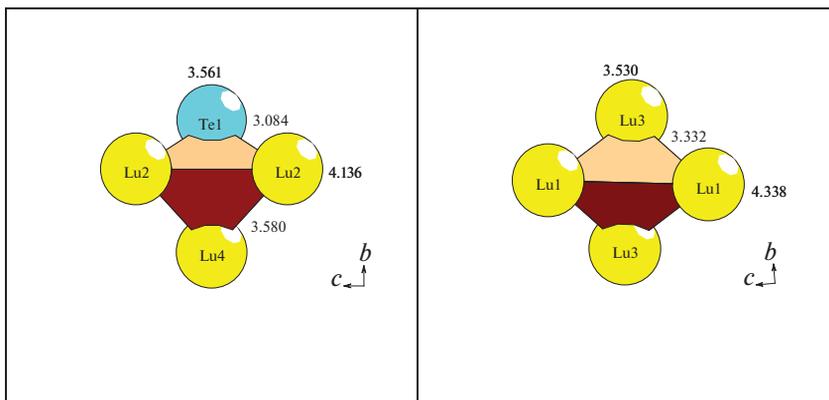


Рис. 2. Кристаллическая структура Lu7Te-*c*C32.

Кластер-прекурсор. Центр кластера-прекурсора *K7* находится в частной позиции $2c$ (0, 0, 1/8) с симметрией $g = 3m$ (рис. 4). На трех гранях тетраэдра TeLu₃ расположены большие атомы Lu2 (с КЧ = 15), образующие связи с атомом Te и двумя атомами Lu1. Атомы-спейсеры Lu3 связаны с атомами Lu1 и Lu2.

Первичная цепь S_3^1 . Самосборка первичных цепей из кластеров *K7* происходит в направлении кратчайшей оси *Z* с индексом связанности кластеров $P_c = 9$ (рис. 4). Атомы-спейсеры Lu3, расположенные между кластерами *K7*, увеличивают индекс связанности кластеров P_c до $9 + 4 = 13$ (рис. 4). Расстояние между центрами кластеров *K7* соответствует значению вектора трансляции $c = 3.687 \text{ \AA}$.

Самосборка слоя S_3^2 . Образование микрослоя происходит при связывании первичных цепей в плоскости *XZ* (рис. 4). Расстояние между центрами кластеров *K7* из соседних цепей в направлении осей *X* соответствует значению вектора трансляции $a = 9.000 \text{ \AA}$.

Самосборка каркаса S_3^3 . Микрокаркас структуры формируется при связывании двух микрослоев S_3^2 (рис. 4). Многократная 3D-конденсация микрокаркаса из восьми кластеров-прекурсоров приводит к самосборке макрокристаллической структуры.

Кристаллическая структура Lu₆₆Te₂₄-*m*C90

Пространственная группа $C12/m1$ (№ 12) с симметрией частных позиций $2/m$ (2a, 2b, 2c, 2d), -1 (4e, 4f), 2 (4g, 4h), m (4i).

В элементарной ячейке Lu₆₆Te₂₄-*m*C90 находятся 90 атомов.

Установлены значения КЧ атомов Te равные 11 (2 атома) и 12 (4 атома), и КЧ атомов Lu равные 13 (2 атома), 14 (12 атомов), 15 (2 атома), 17 (1 атом) (табл. 7).

Из 23 кристаллографически независимых атомов, только атом Lu17 занимает позицию 2a (0,0,0) с симметрией $2/m$, все остальные – 16 атомов Lu и 6 атомов Te находятся в плоскостях *m* в позиции 4i (x, 0, z).

Определены 7 кристаллографически независимых полиэдров в виде пирамиды $K5(2) = 0@Lu_5$ с симметрией 2, тетраэдра $K4(2) = 0@Lu_4$ с симметрией 2, тетраэдра $K4-1 = 0@TeLu_3$, тетраэдра $K4-2 = 0@TeLu_3$, тетраэдра $K4-3 = 0@Te_2Lu_2$, тройных колец $K3-1 = @TeLu_2$ и $K3-2 = @TeLu_2$ (рис. 5).

Выделены супраполиэдрические кластеры – тримеры – образованные из трех кластеров (рис. 5):

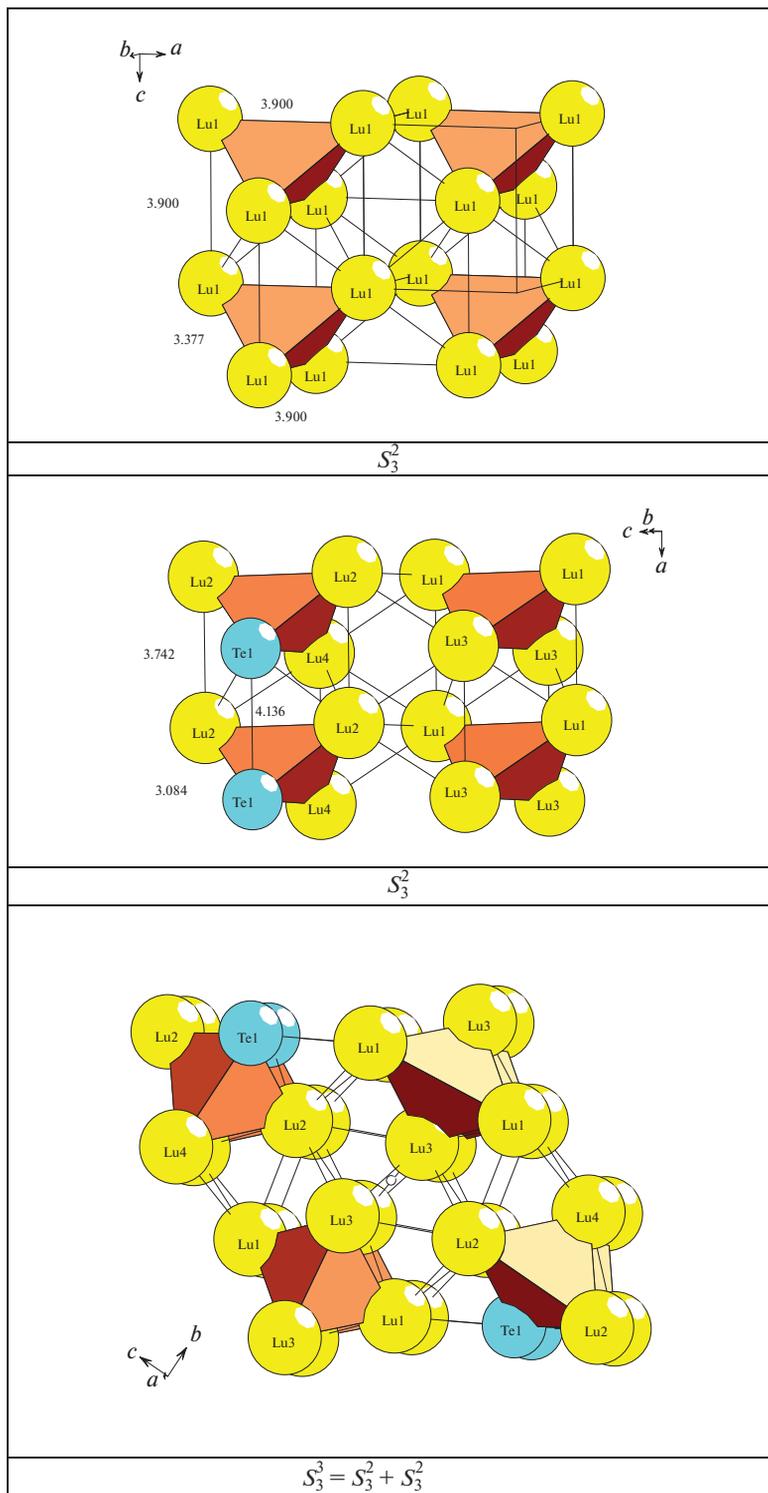


Рис. 3. Кристаллическая структура Lu₇Te-cC₃₂ и Lu-cI₂.

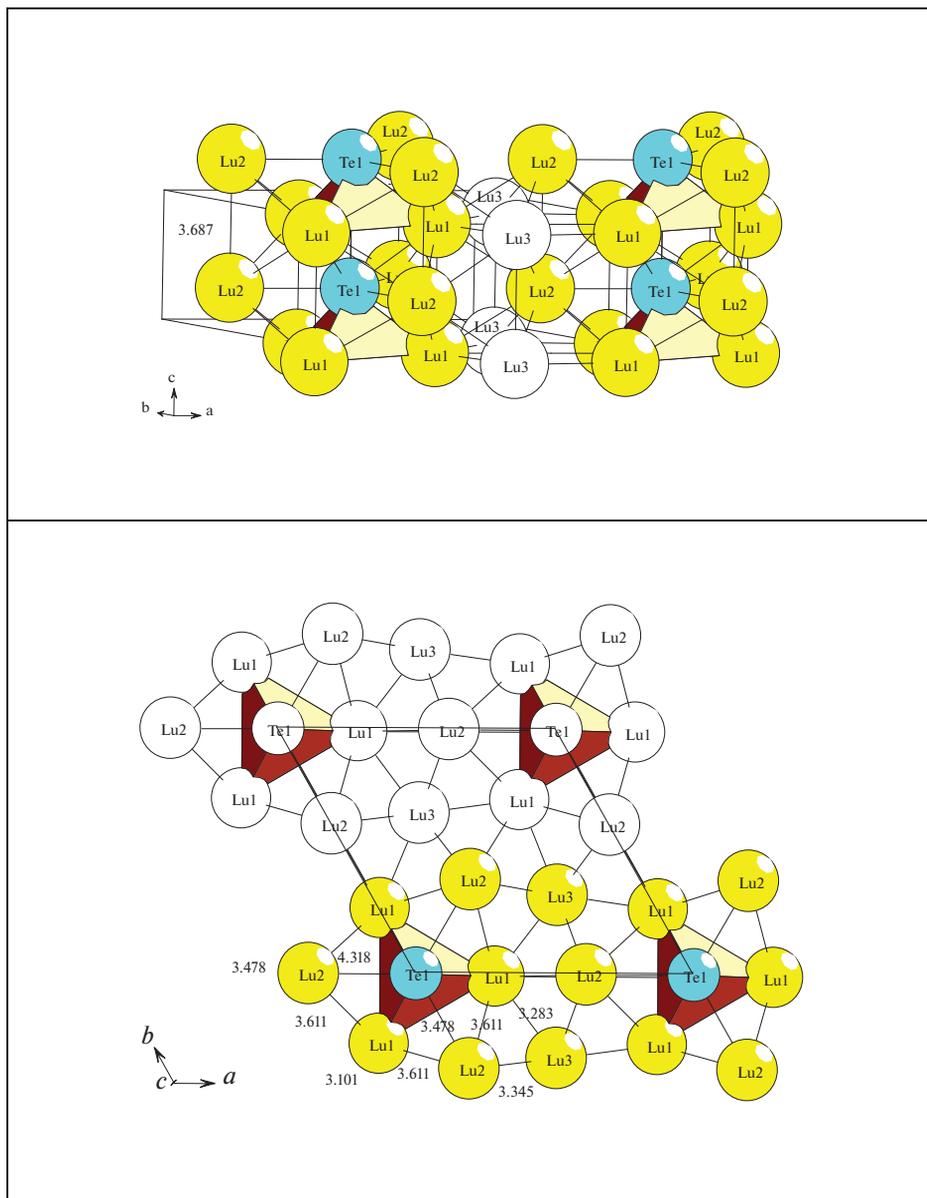


Рис. 4. Кристаллическая структура $\text{Lu}_3(\text{TeLu}_3)\text{P}_2\text{-hP9}$. Слой (сверху) и каркас (снизу).

SSU-1 = пирамида $0@Lu_5$ + 2 кольца $@TeLu_2$,

SSU-2 = тетраэдр $0@Lu_4$ + 2 кольца $@TeLu_2$,

SSU-3 = 2 тетраэдра $0@TeLu_3$ + тетраэдр $0@Te_2Lu_2$

SSU-4 = 2 тетраэдра $0@TeLu_3$ + тетраэдр $0@Te_2Lu_2$.

Самосборка слоя S_3^2 . Образование микрослоя происходит при связывании тримеров в плоскости XZ (рис. 5). Удвоенное расстояние между центром пирамиды $0@Lu_5$ и

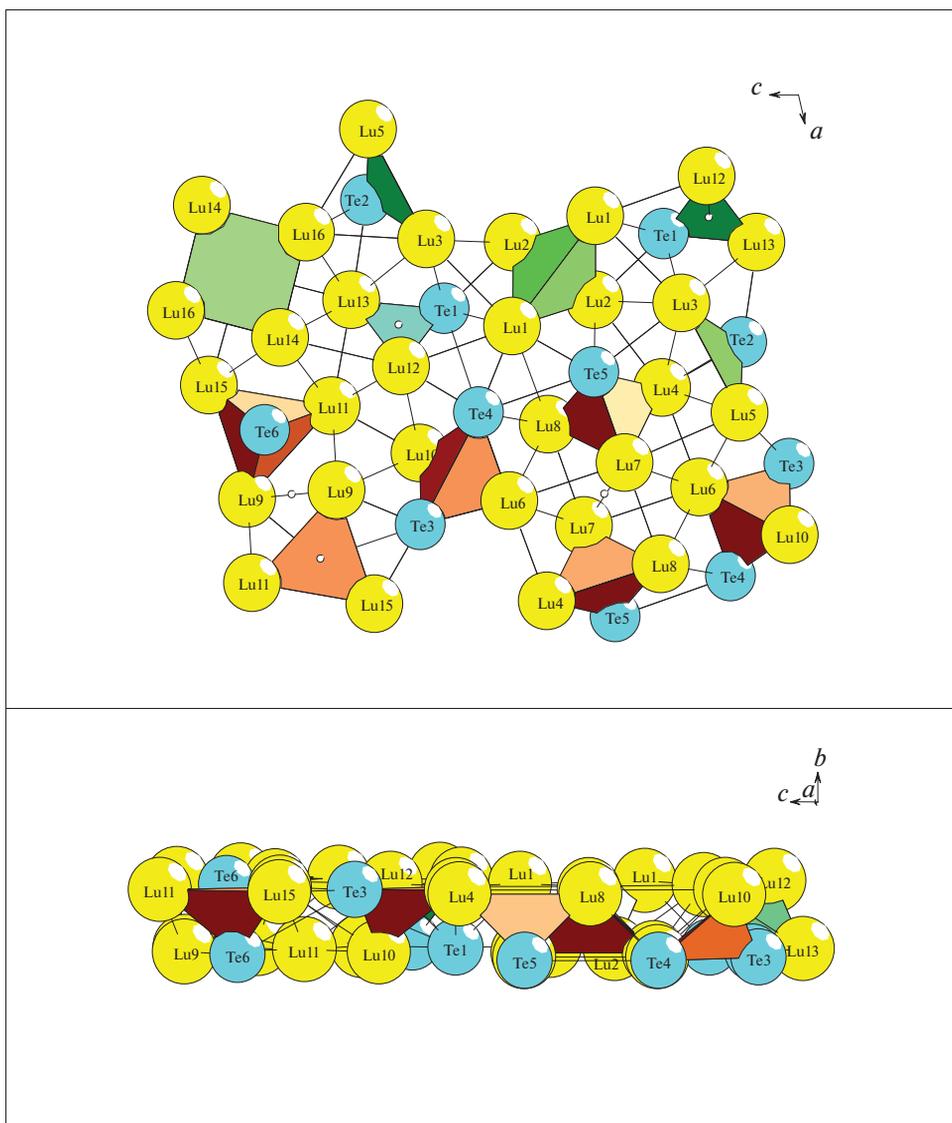


Рис. 5. Кристаллическая структура $\text{Lu}_{66}\text{Te}_{24}\text{-}m\text{C}90$. Слой.

центром тетраэдра $0@Lu_4$ в направлении оси Z соответствует значению вектора трансляции $c = 21.073 \text{ \AA}$.

Самосборка каркаса S_3^3 . Микрокаркас структуры формируется при связывании двух микрослоев S_2^3 в направлении оси Y . Расстояние между слоями соответствует значению вектора трансляции $b = 3.950 \text{ \AA}$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осуществлен комбинаторно-топологический анализ и моделирование самосборки кристаллических структур $\text{Lu}_4\text{Te}_4\text{-}c\text{F}8$, $\text{TeLu}_7\text{-}o\text{C}32$ и $\text{TeLu}_8\text{-}h\text{P}9$ $\text{Lu}_{66}\text{Te}_{24}\text{-}m\text{C}90$. Для

кристаллической структуры $\text{Lu}_4\text{Te}_4\text{-}oF8$ установлены тетраэдрические кластеры-прекурсоры $K4 = 0@Te_2Lu_2$ с симметрией $-43m$, для $Te_4Lu_{28}\text{-}oC32$ – кластеры-прекурсоры $K4 = 0@Lu_4$ и $K4 = 0@TeLu_3$ с симметрией 2 и m , для кристаллической структуры $Lu_3(TeLu_3)Lu_2$ – кластеры-прекурсоры $K7 = 0@Lu_3(TeLu_3)$ с симметрией $3m$ и атомы-спейсеры Lu. Для кристаллической структуры $Lu_{66}Te_{24}\text{-}mC90$ установлены кластеры-прекурсоры в виде пирамиды $K5 = 0@Lu_5$ с симметрией 2, тетраэдры $K4 = 0@Lu_4$ с симметрией 2, тетраэдры $K4 = 0@TeLu_3$ и тетраэдры $K4 = 0@Te_2Lu_2$, и кольца $K3 = @TeLu_2$, участвующие в образовании супракластеров-тримеров. Реконструирован симметричный и топологический код процессов самосборки 3D структур из кластеров-прекурсоров в виде: первичная цепь \rightarrow слой \rightarrow каркас.

Анализ самосборки кристаллических структур выполнен при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения работ по государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН, кластерный анализ выполнен при поддержке Российского научного фонда (РНФ № 21-73-30019).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Inorganic crystal structure database (ICSD). Fachinformationszentrum Karlsruhe (FIZ), Germany and US National Institute of Standard and Technology (NIST), USA.
2. Villars P., Cenzual K. Pearson's Crystal Data-Crystal Structure Database for Inorganic Compounds (PCDIC) ASM International: Materials Park, OH.
3. Cannon J.F., Hall H.T. High-pressure, high-temperature syntheses of selected lanthanide-tellurium compounds // Inorganic Chemistry. 1970. V. 9. P. 1639–1643.
4. Flahaut Jean, Laruelle Pierre, Pardo Marie Paule, Guittard Micheline. Les sulfures, seleniures et tellurures L2X3 de terres rares, d'yttrium et de scandium orthorhombiques du type Sc_2S_3 // Bulletin de la Societe Chimique de France. 1965. V. 1965. P. 1399–1404.
5. Hulliger F., Hull G.W.Jr. Superconductivity in rocksalt-type compounds // Solid State Communications. 1970. V. 8. P. 1379–1382.
6. Chen Ling, Corbett J.D. Lu_8Te and Lu_7Te . Novel substitutional derivatives of lutetium metal // J. Am. Chem. Soc. 2003. V. 125. P. 7794–7795.
7. Chen Ling, Xia Shengqing, Corbett J.D. Metal-rich chalcogenides. Synthesis, structure and bonding of the layered $Lu_{11}Te_4$. Comparison with the similar Sc_8Te_3 and $Ti_{11}Se_4$ // Inorg. Chem. 2005. V. 44. P. 3057–3062.
8. Miller A.E., Daane A.H. The High-Temperature Allotropy of Some Heavy Rare-Earth Metals // Transactions of the Metallurgical Society of Aime. 1964. V. 230. P. 568–572.
9. White J.G., Dismukes J.P. The Crystal Structure of Scandium Sesquitelluride // Inorg. Chem. 1965. V. 4. P. 1760–1763.
10. Assoud A., Kleinke H. The sesquitelluride Sc_2Te_3 // Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online 2006. V. 62. P. i17–i18.
11. Chai P., Corbett J.D. Two new compounds, $\beta\text{-ScTe}$ and Y_3Au_2 , and a reassessment of Y_2Au . // Acta Crystallogr., Sect. C. V. 67. P. i53–i55.
12. Maggard P.A., Corbett J.D. Sc_2Te : A novel example of condensed metal polyhedra in a metal-rich but relatively electron-poor compound // Angewandte Chemie (Edition international). 1997. V. 36. P. 1974–1976.
13. Maggard P.A., Corbett J.D. The synthesis, structure, and bonding of Sc_8Te_3 and Y_8Te_3 . Cooperative matrix and bonding effects in the solid state // Inorg. Chem. 1998. V. 37. P. 814–820.
14. Gupta S., Maggard P.A., Corbett J.D. A bismuth-stabilized metal-rich telluride $Lu_9Bi \sim 1.0Te \sim 1.0$ - Synthesis and characterization // European J. Inorganic Chemistry. 2010. V. 18. P. 2620–2625.
15. Pardo M.P., Flahaut J. Les tellurures superieurs des terres rares, de formules L_2Te_5 et LT_3 // Bulletin de la Societe Chimique de France. 1967. V. 1967. P. 3658–3664.
16. Brixner L.H. Structure and electrical properties of some new rare earth arsenides, antimonides and tellurides // J. Inorganic and Nuclear Chemistry. 1960. V. 15. P. 199–201.
17. Castro-Castro L.M., Chen Ling, Corbett J.D. Condensed rare-earth metal-rich tellurides. Extension of layered (Sc_6PdTe_2)-type compounds to yttrium and lutetium analogues and to Y_7Te_2 , the limiting binary member // J. Solid State Chem. 2007. V. 180. P. 3172–3179.

18. Weirich T.E., Ramlau R., Simon A., Hoymoeller S., Zou X.-D. A crystal structure determined to 0.02 Å accuracy by electron crystallography // *Nature (London)*. 1996. V. 382. P. 144–146.
19. Shevchenko V.Y., Blatov V.A., Ilyushin G.D. Structural Chemistry of Intermetallic Compounds: Geometric and Topological Analysis; Cluster Precursors K_4 , K_6 , and K_{21} ; and Self-Assembly of Crystal Structure Cs_2Hg_2-aP8 , Cs_2Hg_4-oI12 , and $Cs_{10}Hg_{38-tI48}$ // *Glass Physics and Chemistry*. 2022. V. 48. P. 155–162.
20. Ilyushin G.D. Intermetallic compounds Li_kM_n ($M = Ag, Au, Pt, Pd, Ir, Rh$): Geometrical and topological analysis, tetrahedral cluster precursors, and self-assembly of crystal structures // *Crystallography Reports*, 2020. V. 65. P. 202–210.
21. Shevchenko V.Y., Blatov V.A., Ilyushin G.D. Cluster self-organization of intermetallic systems: New two-layer nanocluster precursors $K_{64} = 0@8(Sn_4Ba_4)@56(Na_4Sn_{52})$ and $K_{47} = Na@Sn_{16}@Na_{30}$ in the crystal structure of $Na_{52}Ba_4Sn_{80}-cF540$ // *Glass Physics and Chemistry*. 2020. V. 46. P. 448–454.
22. Ilyushin G.D. Intermetallic Compounds Na_kM_n ($M = K, Cs, Ba, Ag, Pt, Au, Zn, Bi, Sb$): Geometrical and Topological Analysis, Cluster Precursors, and Self-Assembly of Crystal Structures // *Crystallography Reports*. 2020. V. 65. № 4. P. 539–545.
23. Ilyushin G.D. Intermetallic Compounds K_nM_m ($M = Ag, Au, As, Sb, Bi, Ge, Sn, Pb$): Geometrical and Topological Analysis, Cluster Precursors, and Self-Assembly of Crystal Structures // *Crystallography Reports*. 2020. V. 65. № 7. P. 1095–1105.
24. Blatov V.A., Shevchenko A.P., Proserpio D.M. Applied Topological Analysis of Crystal Structures with the Program Package ToposPro // *Cryst. Growth Des.* 2014. V. 14. № 7. P. 3576–3585.